

تأثير التشعيع على الخصائص البصرية لأغشية CdS المحضرة بطريقة التبخير الحراري في الفراغ

هند فاضل عليوي

جامعة بغداد ، كلية العلوم للبنات ، قسم الفيزياء.

الخلاصة

تم في هذا البحث دراسة تأثير التشعيع بأشعة كاما المنبعثة من مصدر الكوبالت ^{60}Co وبجرعات اشعاعية مختلفة (0,1,5,10) على الخواص البصرية لاغشية متجانسة من مادة كبريتيد الكادميوم (CdS) المحضرة بطريقة التبخير الحراري في الفراغ وبسمك ($1\mu\text{m}$) تحت ضغط (10^{-6}Torr) والمرسبة على ارضية زجاجية. تضمنت الدراسة الخواص البصرية للاغشية المشععة وغير المشععة اطيف الفافية والامتصاصية والانعكاسية ضمن مدى الاطوال الموجية (nm 300-900) كما تم دراسة معامل الانكسار ومعامل الخמוד ومعامل الامتصاص وثابت العزل الكهربائي بجزئيه الحقيقي والخيالي كدول لطاقة الفوتون وجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح والممنوع. اظهرت النتائج ان التشعيع ادى الى تغير لون الاغشية الى الاصفر الداكن والى زيادة قيمة معامل الامتصاص ، معامل الخמוד وثابت العزل الخيالي وتتفاوت في قيمة وجوة الطاقة ونقطان في قيمة الانعكاسية ومعامل الانكسار وثابت العزل الكهربائي الحقيقي بزيادة الجرعات الاشعاعية ، كما انه لم يغير من طبيعة شكل هذه المنحنيات عما كانت عليه قبل التشعيع.

المقدمة

تطبيقات التوصيلية الضوئية بالإضافة الى النبات والخلايا الشمسية (5).

تهدف هذه الدراسة الى استخدام طريقة التبخير الحراري في الفراغ حيث ان الاغشية المحضرة بهذه الطريقة تتميز بالانتظام والتجانس وخلوها من الشوائب (6) وبعد ذلك يتم تعريض هذه الاغشية لجرع مختلفة من اشعة كاما ودراسة الخواص الضوئية لهذه الاغشية بعد التشعيع لمعرفة تأثير الجرع الاشعاعية المختلفة على هذه المادة. تم تحضير اغشية CdS المستخدمة في هذا البحث بعدة طرق منها التبخير الحراري في الفراغ وطريق الترذيز (Chemical Bath Deposition) CBD و Sputtering (Metal Organic MOCVD Deposition) (Molecular Beam Spray) (Successive Ionic SILAR و Layer Adsorption and Reaction) Screen (2).

تعد دراسة الخصائص البصرية بدءاً من الثوابت البصرية وحساب وجوة الطاقة البصرية من الدراسات المهمة لعلاقتها بسلوكية المواد شبه الموصلة وتحديد مدى ملائمتها للتطبيقات المختلفة.

ابرزت التقنيات الحديثة تقدماً كبيراً في مجال الالكترونيات ووفرت دراسات متكاملة لاغشية الرقيقة التي كان لها الدور الكبير في الكثير من التطبيقات الصناعية المختلفة كالدواير الالكترونية والمكثفات والخلايا الشمسية والسطح الانقائية المستخدمة في التطبيقات الشمسية الضوئية، اذ تعد تقنية الاغشية الرقيقة واحدة من اهم التقنيات التي ساهمت في تطور دراسة اشباه الموصلات واعطت فكرة واضحة عن العديد من خواصها الفيزيائية والكميائية (1).

من المعروف ان هناك انواعاً مختلفة من الاغشية الرقيقة وكل نوع استخداماته وطرق تحضيره . يعد مركب العركبات شبه الموصلة للمجموعة (CdS) احد (II-VI) ويمثل فجوة طاقة مباشرة (الثانية-ال السادسة) ($\alpha > 10^4\text{cm}^{-1}$) في مدى الطيف المرئي (4,3) ويمكن انتاج اغشية رقيقة منه ذات مواصفات عالية الجودة وبنقنيات متعددة وبتكلفة قليلة ، وقد ازداد الاهتمام بشكل ملحوظ بهذه المادة خلال السنتين الاخيرتين بسبب اثباته نجاحاً في

الجانب العلمي

1- العينات

تم في هذا البحث تحضير أغشية CdS باستخدام منظومة تبخير من نوع (Lybold Coating Unit) تحت ضغط واطيء بحدود 10^{-6} Torr باستخدم حويض مصنوع من المولبيدينوم (Mo) التي تم اختياره لعدم تفاعلها مع مادة CdS ولأن درجة انصهاره عالية (2890K°). تم ترسيب الأغشية بسمك ($1\mu\text{m}$) على قواعد زجاجية من Soda glass في درجة حرارة الغرفة وبمعدل ترسيب (360Å/s).

2- القياسات البصرية

اجريت القياسات البصرية التي تشمل الامتصاصية (Transmittance) (A) والنفاذية (T) (Absorbance) لاغشية (CdS) غير المشععة والمشععة بجرعات مختلفة من اشعة كاما ولمدى الاطوال الموجية (300-900nm) بواسطة جهاز زار UV/VIS Double Beam Spectrophotometer pu-8800 من قبل شركة (Philips).

3- التشعيع

تم تشعيع العينات باستخدام اشعة كاما المنبعثة من مصدر ^{60}Co باستخدام جهاز التشعيع Chamber 900 المتوفّر في قسم الفيزياء-كلية العلوم-جامعة بغداد. تم تشعيع العينات في الهواء عند درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي الاعتيادي.

النتائج والمناقشة

1. طيف الامتصاصية والنفاذية Transmittance and Absorbance

تم قياس اطيف الامتصاصية والنفاذية لاغشية (CdS) كدالة لطاقة الفوتون قبل وبعد التشعيع بجرعات اشعاعية مختلفة من اشعة كاما والشكلان (2,1) بوضوح اطيف الامتصاصية والنفاذية كدوال لطاقة الفوتون للنمذاج المحضرة ونلاحظ من هذين الشكلين ان الامتصاصية تتزداد والنفاذية تقل مع زيادة الجرعات اشعاعية.

2. معامل الامتصاص Absorption coefficient

تم حساب قيمة معامل الامتصاص البصري وفق

$$\text{المعادلة الآتية}(7)$$

$$\alpha = 2.303(A/t) \quad [1]$$

حيث ان: α : معامل الامتصاص (cm^{-1}) ، t : سمك الغشاء المحضر (μm) ، A : الامتصاصية تم قياس سمك الغشاء بالطريقة الوزنية وطريقة التداخل الضوئي التي تعد من افضل الطرق الدقيقة في قياس سمك الاغشية (8)، يوضح الشكل (3) تغير معامل الامتصاص مع طاقة الفوتون لاغشية (CdS) كدالة للجرع الاشعاعية ونلاحظ من الشكل ان معامل الامتصاص يزداد تدريجياً بزيادة طاقة الفوتون.

من الشكل نفسه نلاحظ ان هناك منطقتين توضحان علاقة معامل الامتصاص مع طاقة الفوتون:

• منطقة الطاقات الفوتونية الواطئة ($h\nu < 2.25\text{eV}$)

وفيها يتغير معامل الامتصاص تغيراً طفيفاً مع زيادة طاقة الفوتون حيث نلاحظ ان معامل الامتصاص يكون ثابتاً تقريباً عند تلك المنطقة.

• منطقة الطاقات الفوتونية العالية ($h\nu > 2.25\text{eV}$)

يزداد فيها معامل الامتصاص زيادة سريعة مع زيادة طاقة الفوتون. ان هذه الزيادة السريعة والمفاجئة تساعد في تعين حافة الامتصاص الاساسية والتي تحدث نتيجة انتقال الالكترونات من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل.

لقد اظهرت النتائج التي حصلنا عليها ان كبريتيد الكادميوم يتمثل معامل امتصاص عالي يصل مداه إلى (10^4cm^{-1}) عند الطاقات الفوتونية العالية وهذا يرجح احتمالية حصول الانتقالات الا لكترونية المباشرة وبصورة كبيرة ولكن هذا لا يمنع من حصول الانتقالات غير المباشرة، ان التشعيع لم يغير شكل طبيعة منحنى معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون قبل التشعيع ويلاحظ ان معامل الامتصاص يزداد بزيادة الجرعات الاشعاعية الممتدة خاصة عند الطاقات العالية ، ويعزى سبب هذه الزيادة في معامل الامتصاص الى ان التشعيع تسبب في توليد مستويات مانحة داخل فجوة الطاقة المنووعة وقريبة

قيمة معامل الامتصاص عند هذه الطاقة يصل مداها الى (10^3 cm^{-1}) مما يؤكد ان قيمة الطاقة المحسوبة هي فجوة الطاقة للانتقال المباشر الممنوع ، ويلاحظ من الشكل ان قيم فجوة الطاقة بعد التشعيع تقل بزيادة الجرعات الاشعاعية الممتصة والجدول (2) يبين قيم فجوة الطاقة للانتقال المباشر الممنوع للاغشية قبل التشعيع وبعد وله عدد من الجرعات الاشعاعية الممتصة المختلفة.

(1) جدول

قيم فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح.

الجرعة (Mrad)	فجوة الطاقة (eV)
0	2.4
1	2.4
5	2.25
10	2.25

(2) جدول

قيم فجوة الطاقة للانتقال المباشر الممنوع.

الجرعة (Mrad)	فجوة الطاقة (eV)
0	2.16
1	2.08
5	2.07
10	2.06

يوضح الشكل تغيراً خطياً عند مدى الطاقات العالية ولم يظهر هذا السلوك مع المنحنيات الأخرى مما يشير إلى حصول الانقال الإلكتروني المباشر المسموح للاغشية المحضرة، هناك تفاوت بين القيم المستحصلة لفجوة الطاقة وتتأثرها بآلية تكوين الاغشية والظروف المصاحبة لعملية التحضير.

تعتمد قيمة فجوة الطاقة ونوعها على التركيب البلوري للمادة وكيفية توزيع الذرات في الشبكة البلورية وتركيب المستويات الطاقية [9]، وهذا يعني ان أي تغير في الخصائص التركيبية والمعلمات الأخرى يكون سبباً في احداث تغيراً في قيمة فجوة الطاقة وفي نوع الانتقالات التي تحصل في الاغشية.

4. عرض الظيول للمستويات الموضعية

ان السمة الاساسية لحافة الامتصاص البصري لأشباه الموصلات هي الزيادة الاسمية لمعامل الامتصاص مع طاقة

من حزمة التوصيل وهذا ما سبب زيادة احتمالية امتصاص الفوتوتونات ذات الطاقات الواطئة .

يلاحظ ان معامل الامتصاص يتغير مع تغير طاقة الفوتوتون بصورة بطيئة عند الطاقات الواطئة ثم يزداد التغير بسرعة بالقرب من حافة الامتصاص وكذلك فان التشعيع ادى الى تغير لون اغشية (Cds) الصفراء الشفافة الى اللون الاصفر القائم مع زيادة الجرعات الاشعاعية الممتصة لذا نرى ان النفادية تقل عند زيادة نسبة التشعيع.

3. فجوة الطاقة البصرية Optical Band Gap

تم حساب فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح باستخدام العلاقة الآتية:

$$(\alpha h\nu)^2 = \alpha^2(h\nu - E_g) \dots \dots \dots [2]$$

وذلك برسم العلاقة البيانية بين $(\alpha h\nu)^2$ و طاقة الفوتوتون ($h\nu$)، بمد الجزء الخطى من المنحنى ليقطع محور طاقة الفوتوتون عند النقطة $= 0$ $(\alpha h\nu)^2$ لنجصل على قيمة فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح للاغشية (Cds).

يوضح الشكل (4) قيم فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح للاغشية (Cds) قبل وبعد التشعيع يلاحظ ان قيم فجوة الطاقة تقل بعد التشعيع عما هي عليه قبل التشعيع بزيادة الجرعات الاشعاعية الممتصة والجدول (1) يبين قيم فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح للاغشية . ويمكن تفسير النقصان في قيم فجوة الطاقة الى ان التشعيع قد ادى الى خلق مستويات مانحة داخل فجوة الطاقة بالقرب من حزمة التوصيل وان وجود هذه المستويات المانحة يزيد من احتمالية امتصاص الفوتوتونات ذات الاطوال الموجية الطويلة مما يؤدي الى تقليل قيمة فجوة الطاقة.

اما فجوة الطاقة للانتقال المباشر الممنوع فقد تم حسابها بالاعتماد على العلاقة الآتية:

$$(\alpha h\nu)^{2/3} = \alpha^{2/3}(h\nu - E_g) \dots \dots \dots [3]$$

ترسم العلاقة بين $(\alpha h\nu)^{2/3}$ و طاقة الفوتوتون ($h\nu$) وبمد الجزء الخطى المستقيم من المنحنى ليقطع محور طاقة الفوتوتون عند النقطة $= 0$ $(\alpha h\nu)^{2/3}$ نحصل على قيمة فجوة الطاقة للانتقال المباشر الممنوع للاغشية (Cds) قبل التشعيع وبعده. والشكل (5) يمثل فجوة الطاقة للانتقال المباشر الممنوع للاغشية (Cds) قبل وبعد التشعيع وان

التشعيع لم يظهر تأثيراً ملحوظاً على طبيعة منحنى الانعكاسية بما كانت عليه قبل التشعيع لكنه سبب نقصان في قيم الانعكاسية خاصة في منطقة الطاقات الواطئة بزيادة الجرعات الممتصصة، ان سبب هذا التغير هو الاختلاف في امتصاصية الاغشية فضلاً عن التركيب البلوري للاغشية.

6- معامل الخمود Extinction Coefficient

يتمثل معامل الخمود كمية الطاقة الممتصصة في الغشاء الواقف أو الخمود الحاصل في الموجة الكهرومغناطيسية داخل المادة ويتمثل بالجزء الخيالي من معامل الانكسار بموجب العلاقة

$$n=c/v=n-ik \quad [6]$$

تم حساب معامل الخمود اعتماداً على معامل امتصاص وفقاً للعلاقة (9):

$$k = \left(\frac{\alpha\lambda}{4\pi} \right) \quad [7]$$

حيث ان:

k : معامل الخمود

λ : الطول الموجي.

يبين الشكل (8) تغير معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون لغشاء (CdS) قبل التشعيع وبعد واجهات اشعاعية مختلفة، ويلاحظ ان معامل الخمود يزداد تدريجياً بتزايد طاقة الفوتون ثم يتراقص تدريجياً يعقبها زيادة سريعة جداً عند الطاقات الفوتونية المقابلة لحافة الامتصاص ، وهذه الزيادة قد تكون ناتجة عن الزيادة السريعة لمعامل الامتصاص عند هذه الطاقات. يلاحظ ايضاً ان معامل الخمود يسلك سلوكاً مشابهاً لمعامل الامتصاص لارتباط معامل الخمود مع معامل الامتصاص بموجب العلاقة [7] حيث يزداد معامل الخمود بزيادة معامل الامتصاص. ان سلوك منحنى معامل الخمود بعد التشعيع مشابه لسلوكه قبل التشعيع مما يستنتج ان التشعيع لم يؤثر بصورة ملموسة على منحنى معامل الخمود ولكنه سبب زيادة في قيم معامل الخمود خاصة عند الطاقات العالية.

7. معامل الانكسار Refractive Index

معامل الانكسار هو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ الى سرعته في الوسط وتم حساب معامل الانكسار للاغشية المحضرية قبل وبعد التشعيع حسب المعادلة الآتية (10).

الفوتون، ان هذا الجزء من الطيف يعرف بذيل اورباخ (Urbach tail) ويعبر عن معامل الامتصاص في هذا الجزء وفقاً لعلاقة اورباخ بالعلاقة التالية:

$$\alpha = \alpha_0 \exp(hv/E_t) \quad [4]$$

تم حساب عرض الذيل الممثل للمستويات الموضعية

(E_t) لمادة (CdS) من خلال رسم العلاقة بين ($\ln \alpha$) وطاقة الفوتون ومن ميل الجزء المستقيم للمنحنى تم حساب قيمة (E_t) حيث تساوي مقلوب الميل ويوضح الشكل (6) عرض الذيل الممثل للمستويات الموضعية لاغشية (CdS) غير المشععة والمشععة بجرع مختلفة من اشعة كاما. كما موضحة بالجدول (3)، نلاحظ من الجدول ازدياد قيمة عرض الذيل بزيادة الجرعة الانشعاعية وذلك لأن التشعيع ادى الى زيادة العشوائية في الغشاء حيث ان الطاقة سببت اهتزاز الذرات وكذلك احتمالية حدوث خلل في تركيب هذه المادة.

جدول (3)

قيم عرض الذيل الممثل للمستويات الموضعية لاغشية CdS لجرع مختلفة.

الجرعة (Mrad)	E_t (eV)
0	0.24
1	0.243
5	0.246
10	0.247

5. الانعكاسية Reflectance

الانعكاسية هي النسبة بين الشعاع المنعكس والشعاع الساقط عند الحد الفاصل بين وسطين ، تم حساب الانعكاسية من طيفي الامتصاصية والنفاذية وبموجب قانون حفظ الطاقة (8):

$$R = 1 - A - T \quad [5]$$

يوضح الشكل (7) تغير طيف الانعكاسية كدالة لطاقة الفوتون لاغشية (CdS) قبل وبعد التشعيع بجرع اشعاعية مختلفة من اشعة كاما ويلاحظ تزايد الانعكاسية تدريجياً مع تزايد طاقة الفوتون بعدها يحصل هبوط تدريجي في الانعكاسية مع زيادة طاقة الفوتون ويلاحظ من الشكل ان

الاستنتاجات

- في ضوء الدراسة الحالية تم استنتاج ما يلي:
1. ان التشيع يؤدي الى زيادة معامل الامتصاص.
 2. ان التشيع يؤدي الى تغيير لون اغشية كبريتيد الكادميوم من الاصفر الشفاف الى الاصفر القاتم بزيادة الجراثيم الاشعاعية المتنفسة.
 3. ان العلاقة بين معامل الامتصاص، معامل الانكسار، الانعكاسية، ثابت العزل الكهربائي بجزئيه الحقيقي والخيالي ومعامل الخمود مع طاقة الفوتون هي علاقة اسية، وان التشيع لم يغير من طبيعة هذه المنحنيات المذكورة اعلاه عما كانت عليه قبل التشيع.
 4. ان التشيع يؤدي الى تقليل فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح والممنوع.
- ان التشيع ادى الى زيادة قيم الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي عند الطاقات العالية ولكن لم يؤثر بشكل واضح على طبيعة منحني الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي كدالة طاقة الفوتون.

References

- [1] K.L. Chopra, "Thin films phenomena", McGraw-Hill, (1969) NewYork.
- [2] A. Ates, M.A. Yildirim, M.kundakci and M. Yildirim, "Investigation of optical and structural properties of CdS thin films, Chinese J. of Phys., 45, 2-1, (2007) 135-141.
- [3] H. Heo, R. Thn, R.Lee, Y. Han and D. Kim" Solar Energy Maerials and Solar Cells", 75, (2003) 193-203.
- [4] L.R. Cruz, R.R. de Avillez, de Superficies Y de Vacio9, (1999) 92-95.
- [5] S.K.Al-Ani, R.A. Ismail, H.F.Al-Ta`ayIraqi J. of Appl. Phys.1,2, .(2005) 13-17.
- [6] S.K.J. Al-Ani, R.A. Ismail, and H.F. A-Taa`y, J. Mater Sci., Mater Electron, 17, (2006) 819-824.
- [7] G.G. Rusu and I. Caraman, A: Appl. Phys., Vol.70,5, (2000) 565.
- [8] R.A.Smith "Semiconductors", Cambridge, University Press 2nd ed, (1990).
- [9] J.I. Pankove, "Optical processes in semiconductors", Prentice-Hall, New Jersey, (1971).

$$n = [(1+R/1-R)^2 - (k^2 + 1)^{1/2} + [(1+R)/(1-R)] [8]$$

يبين الشكل (9) تغير معامل الانكسار مع طاقة الفوتون كدالة للجرع الاشعاعية لاغشية (CdS) المحضر. تبين النتائج ان طبيعة تغير معامل الانكسار مع طاقة الفوتون للغضاء نفسه لارتباط معامل الانكسار مع الانعكاسية بموجب المعادلة [3]. اما بالنسبة لاغشية (CdS) بعد التشيع فنجد ان طبيعة تغير معامل الانكسار مع طاقة الفوتون لم تتأثر كثيرا بالتشيع لكن نلاحظ نقصان في قيم معامل الانكسار عند الطاقات الواطنة.

8. ثابت العزل الكهربائي

يعطي ثابت العزل الكهربائي المعقد للوسط بالعلاقة الآتية:

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 - i\epsilon_2 [9]$$

حيث ان: ϵ_1 : الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي ϵ_2 : الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي.

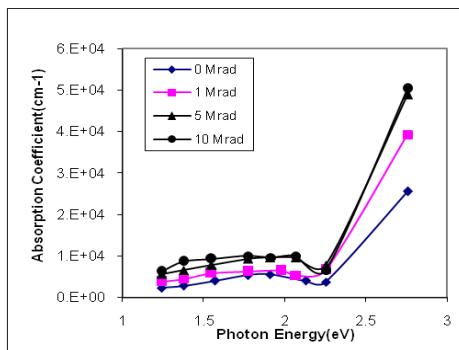
يتم حساب ثابت العزل الكهربائي بجزئيه الحقيقي والخيالي لاغشية (CdS) من خلال العلاقات الآتىتين:

$$\epsilon_1 = n^2 - k^2 [10]$$

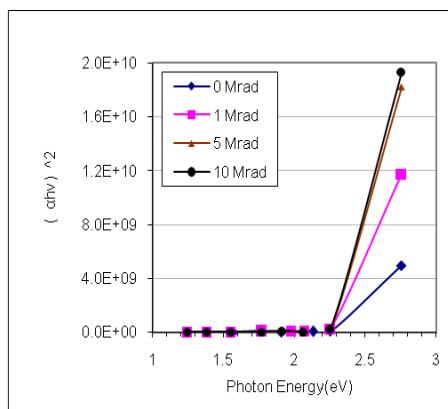
$$\epsilon_2 = 2nk [11]$$

يمثل الشكل (10) تغير ثابت العزل الحقيقي كدالة لطاقة الفوتون لاغشية (CdS) قبل التشيع وبعدة . يلاحظ من الشكل ان ثابت العزل الحقيقي يتناقص تدريجيا بزيادة الجراثيم الاشعاعية المتنفسة بصورة طفيفة ، كما يلاحظ ايضا ان ثابت العزل الحقيقي يتصرف مثل تصرف معامل الانكسار لارتباطه مع ϵ بالعلاقة (10) حيث يكون تأثير معامل الخمود قليل جدا مقارنة بتاثير معامل الانكسار بالنسبة لاغشية غير المشعنة، اما بالنسبة لاغشية المشعنة فقد أظهر التشيع تأثير واضح على طبيعة تغير الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي مع طاقة الفوتون.

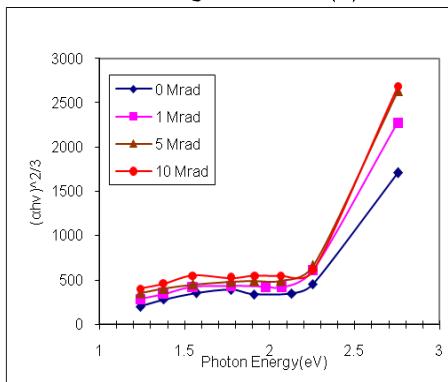
اما الشكل (11) فيمثل تغير ثابت العزل الخيالي كدالة لطاقة الفوتون لاغشية (CdS) قبل التشيع وبعدة . يلاحظ من الشكل ان طبيعة تغير منحني الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي مع طاقة الفوتون مشابه لطبيعة تغير معامل الخمود مع طاقة الفوتون.



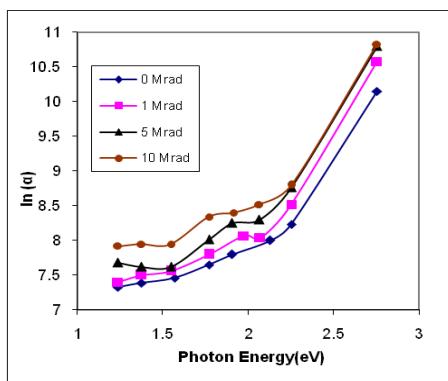
الشكل (3) تغير معامل الامتصاص البصري مع طاقة الفوتون.



الشكل (4) ($ahv)^2$ مع طاقة الفوتون.



الشكل (5) $(ahv)^{2/3}$ مع طاقة الفوتون.



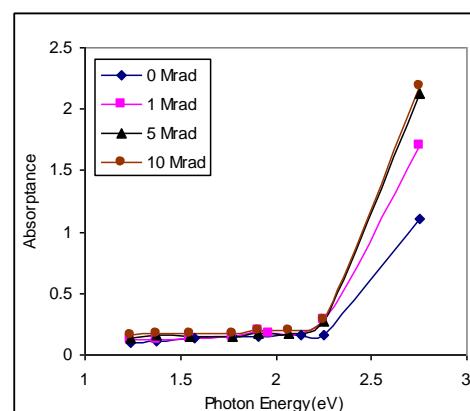
الشكل (6) $\ln(a)$ مع طاقة الفوتون.

[10] M.F. Alias, "Optoelectronic study of a Se-Ge-Al a-Si-Ge-Al(As)": H Films, Ph.D.Thesis, University of Baghdad, Department of physics (1998).

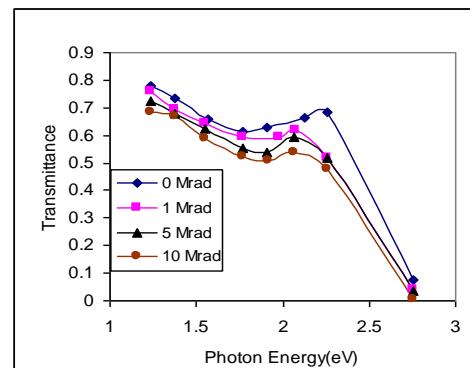
Abstract

Effect of Gamma Radiation with different doses (0,1,5,10) Mrad was studied on the optical properties for CdS films of $1\mu\text{m}$ thickness prepared by thermal evaporation at pressure (10^{-6}torr) on glass substrate.

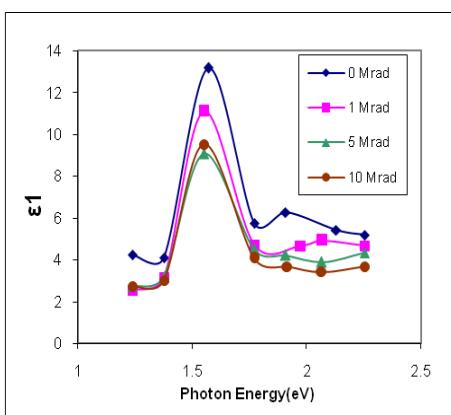
The optical properties of CdS films, absorbance, transmittance and reflectance have been studies in the wavelength range of (300-900)nm. The refractive index, extinction coefficient, absorption coefficient and dielectric constant were also studied as a function of photon energy and optical energy gap of allowed direct and forbidden transition. Radiation is change films colour to dark yellow and increase the value of absorption coefficient, extinction coefficient and dielectric constant while occurs decreasing on the Reflectance, Refractive index and dielectric constant .



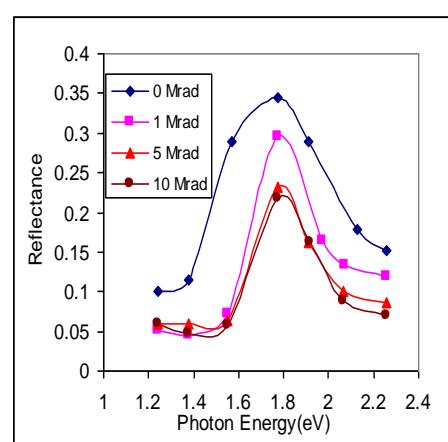
الشكل (1) طيف الامتصاصية لغشاء CdS دالة لطاقة الفوتون.



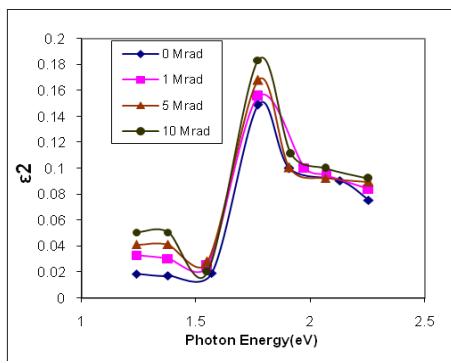
الشكل (2) طيف النفاذية لغشاء CdS دالة لطاقة الفوتون.



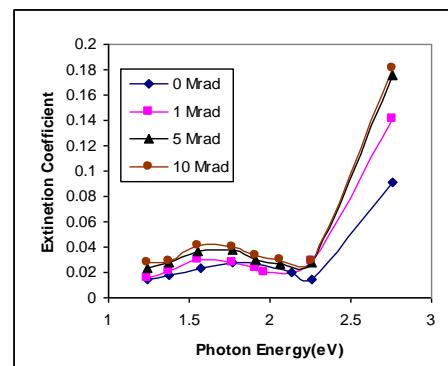
الشكل (10) الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي دالة لطاقة الفوتون.



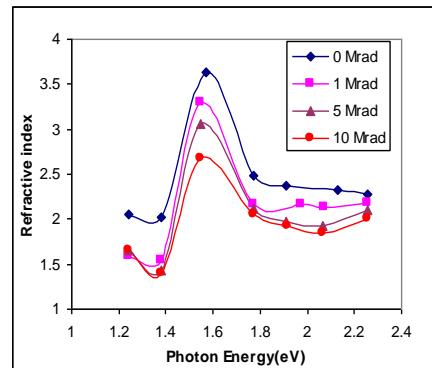
الشكل (7) طيف الانعكاسية لغشاء CdS دالة لطاقة الفوتون.



الشكل (11) الجزءخيالي لثابت العزل الكهربائي دالة لطاقة الفوتون.



الشكل (8) تغير معامل الخمود مع طاقة الفوتون.



الشكل (9) تغير معامل الانكسار مع طاقة الفوتون.